

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
2. Juni 2005 (02.06.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/050746 A3**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01L 33/00**,  
31/02, 31/0203, H01S 5/042, 5/02

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/052676

(22) Internationales Anmeldedatum:  
27. Oktober 2004 (27.10.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
103 53 679.5 17. November 2003 (17.11.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];  
Witelsbacherplatz 2, 80333 München (DE). OSRAM  
OPTO SEMICONDUCTORS GMBH [DE/DE]; Werner-  
werkstrasse 2, 93040 Regensburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GÜNTHER, Ewald  
[DE/DE]; Espenthal 10, 93128 Regensburg (DE). SORG,  
Jörg-Erich [DE/DE]; Gozratstrasse 12, 93053 Regensburg  
(DE). WEIDNER, Karl [DE/DE]; Zauserweg 6, 81245  
München (DE). ZAPF, Jörg [DE/DE]; Dalandstrasse 1,  
81927 München (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-  
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München  
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,  
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,  
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,  
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,  
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,  
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,  
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,  
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,  
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,  
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

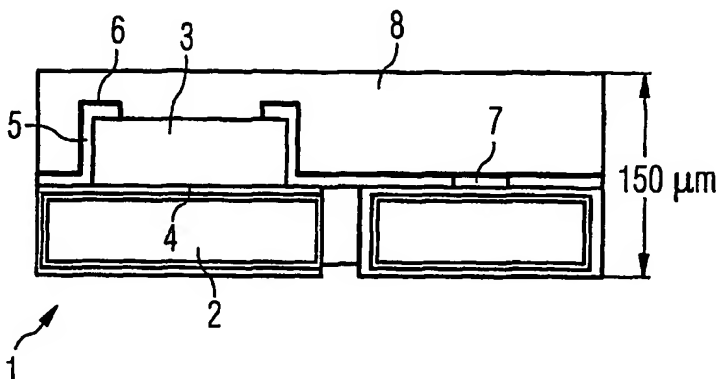
— mit internationalem Recherchenbericht  
— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden  
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen  
eintreffen

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen  
Recherchenberichts: 28. Juli 2005

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-  
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-  
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der  
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ECONOMIC MINIATURIZED CONSTRUCTION TECHNIQUE AND CONNECTION TECHNIQUE FOR LIGHT  
EMITTING DIODES AND OTHER OPTO-ELECTRONIC MODULES

(54) Bezeichnung: KOSTENGÜNSTIGE, MINIATURISIERTE AUFBAU- UND VERBINDUNGSTECHNIK FÜR LEUCHTDI-  
ODEN UND ANDERE OPTOELEKTRONISCHE MODULE



(57) Abstract: The invention  
relates to a product comprising a  
substrate with an opto-electronic  
component which is contacted in  
a planar manner.

(57) Zusammenfassung: Ein  
Erzeugnis weist ein Substrat  
mit einem optoelektronischen  
Bauelement auf, das planar  
kontaktiert ist.

WO 2005/050746 A3